



سعدالدين

خميسي

أستاذ محاضر "أ"

البروفيل

قسم علوم المادة، كلية العلوم و التكنولوجيا

Khemissi.saadeddine@univ-khenchela.dz

0662559694



اللغة

العربية

الإنجلز

الفرنسي

المعلومات

1999

دبلوم الدراسات العليا في فيزياء الجسم الصلب
جامعة قسنطينة

2003

ماجستير في فيزياء أنصاف النواقل
جامعة قسنطينة

2009

دكتوراه في فيزياء أنصاف النواقل
جامعة قسنطينة

2013

شهادة التأهيل الجامعي

جامعة أم البواقي

أستاذ محاضر

جامعة عباس لغرور خنشلة

1- N. Merabtine, S. Khemissi, M. Zaabat, M. Belgat, C. Kenzai

« Accurate numerical modelling of GaAs MESFET current-voltage characteristics »

Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, Vol 7, N°4 pp 389-394. 2004.

http://journal-spqeo.org.ua/n4_2004/389_394.htm

2- S. Khemissi, N. Merabtine, M. Zaabat, C. Kenzai, Y. Saidi, S. Amourache.

« Influence of physical and geometrical parameters on electrical properties of short gate GaAs MESFETs », Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics, Vol 9, N°2 pp 34- 39, 2006.

http://journal-spqeo.org.ua/n2_2006/P034-039.htm

3- S. Khemissi, C. Azizi

"A Two-Dimensional Analytical Modeling of the Current-Voltage Characteristics for submicron Gate-Length GaAs MESFET's", International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS, Vol: 12, N°: 04, pp. 27-33, 2012.

http://ijens.org/Vol_12_I_04/126104-7373-IJET-IJENS.pdf

4- C. Kaddour, C. Azizi, S. Khemissi, M. Zaabat et Y. Saidi.

« Analytical Model for GaAs MESFET with High Pinchoff Voltage », Journal of Materials Science and Engineering A 3 Vol 12 pp. 853-858, 2013.

5- S. Kattar, S. Khemissi,

« I-V Characteristics Modeling of the Carbon Nanotube Field Effect Transistor (CNTFET) », Jordan Journal of Physics, Vol 15, N 3, pp. 279-288, 2022

6- M. Droudj, S. Khemissi,

« Modeling and Simulation of Current Voltage Characteristics for Cylindrical CNTFET Transistor », Jordan Journal of Physics, Vol 16, N 5, pp. 517-526, 2023.